

IST 878型 技术规格

功能测试中的驱动条件

泄漏电流测量参数	
双极管 / MOSFET晶体管:	I _{ce} , I _{eo} , I _{bo} , & I _{ss}
二极管, IR, 晶闸管 (SCR/TMIC), I _{dm} :	
低驱动:	I _c ≤ 10 mA I _b ≤ 0.9 mA
高驱动:	I _c ≤ 350 mA I _b ≤ 75 mA
驱动脉冲:	≤ 300 μs

MOSFET和L-TEN泄漏电流测量参数	
MOSFET, I _{ess}	
测试范围 *	分步率
0~400 nA	+/- 2%
0~4 mA	+/- 1%
0~40 mA	+/- 1%
0~400 mA	+/- 1%
0~4000 mA	+/- 1%
0~40000 mA	+/- 1%
DUT输出级值级	高
1	3 mA
2	10 mA
3	30 mA
4	35 mA
5	40 mA
6	50 mA
7	70 mA

击穿电压测量参数	
双极管/MOSFET晶体管, Br _{ceo} , Br _{bo} , Br _{co} 和UB _{dss}	
测试范围 *	分步率
0~30 V	+/- 1%
30~1,099 V	+/- 1%
高压电源	
最大输出电压, 1,099 V	
最大输出瓦特, 3 W	

* = 自动调节范围

DUT输出级值级		外电路		内电路	
高	11.0 V		6.80 V		
低	1.18 V		2.20 V		

二极管正向电压 (Vf) 测量	
最低 (Vf) > 0.1 V, 正向电流, 50 mA ~ 1,000 mA	
Zener二极管偏置电压 (Vz)	
0.1V ~ 30V, 偏置电流, 3 mA ~ 80 mA	

稳压器输出电压 (+/- V_o)

0.2 V ~ 36.0 V, 输出负载电流, 50 mA ~ 1.0 AMP

二极管反向电压 (Vr) 测量	
双极管, IR, 二极管:	0~30 V
SCR, TRIAC:	0~300 V

最高 (Vr) > 300 V, 偏置电流, 50 mA ~ 1.0 AMP

IST 878型是一种低成本测试仪器，能提供内电路或外电路的测试，可用于多数分立式半导体，包括：

- 双极晶体管
- MOSFET
- IGBT
- 二极管
- Zener二极管
- 结型场效应管
- SCR
- TRIAC
- TVS (压敏电阻，STDAC)

尺寸: 宽 x 高 x 深 x 长 (23.3 cm x 16 cm x 7.1 cm)
9.2" 宽 x 6.3" 高 x 2.8" 深

装运重量:

7.5 lbs (3.4kg)

交流/交流电源适配器:

输入: 120 VAC 或 220 VAC +/- 5% 50/60 Hz
输出: 36 VAC, C.T. 最大值 800mA

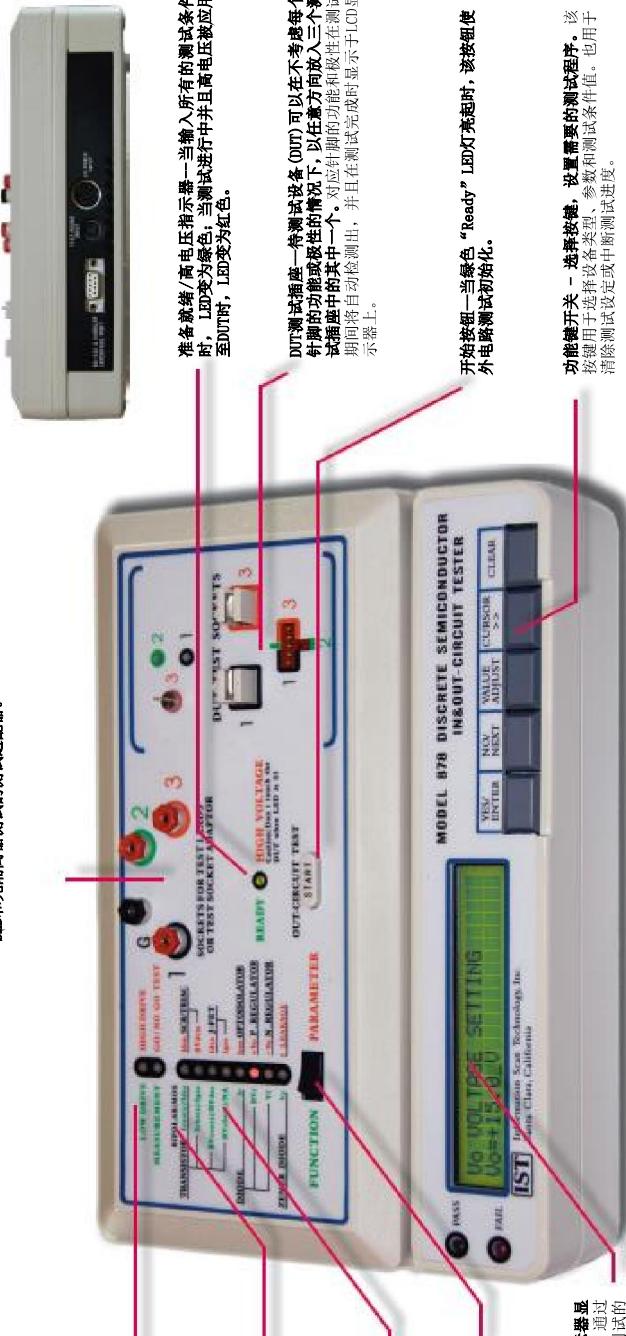
提供配件:

- 120 V 或 220 V 交流电源适配器
- 指导手册
- 用于内电路测试的三点探针设备
- 用于测试SMD包的测试插座适配器
- 三色编码测试线 w/ 连接器和测试夹
- 测试光隔离器的测试插座适配器
- 用于大量产出测试的高负载测试插座适配器



IST 878型 可编程功率器件参数测试器 用于半导体设备

测试适配器插座—用于测试尾线，带有微型香蕉型插头，或用于进行
SMD和无隔离器测试的测试适配器。



低/高驱动—指示出DUT需要低或高驱动电流以保证通过功能测试。高驱动电流指示出DUT具有较差的电流调节或某种程度上的故障。

测量/测试模式—指示出当前模式为测量或“进行/不进行 (Go/No Go)”测试模式。

LCD显示器和参数指示器—LED显示出测试设定，其中参数为最亮，测试类型为红灯。

LCD显示器和状态指示器—2x24 LCD显示器显示用户操作、测试结果和其他操作信息。通过或不通过 (Pass/Fail) LED显示出行功能 (Go/No Go)。

特点和优势：

无设置
配置测试设置允许待测设备 (DUT) 进行任意负载。然后自动检测DUT的极性、功能和方向。测试前不需要找到正确的针脚接入。

可存取结果
通过或未通过LED指示器迅速显示出测试结果状态。背光LCD显示器显示出观察到的测量情况：参数数据、设备类型、设备分类以及每个针的功能或极性。

检测电流泄漏
灵敏电流测量能检测出具有泄漏问题的损坏或退化设备。

多用途操作
多个测试插座和测试插座适配器，为绝大多数型号的穿孔和SMD组件测试提供支持。

恒定电流吸收或电流偏置
在用于稳压器输出负载的恒定电流吸收、用于测量双极管或齐纳双极管电压的电流偏置之间进行切换。

指尖测试激活
具有指尖测试激活按钮的3点探针设备，能够进行快速、便捷的内路PCB测试。

可编程电源
1,099伏特可编程电源，用于击穿电压和泄漏电流测试。

包括22种测试常规类型。
双极晶体管 (I_{CEO}、I_{CES}、I_{CHO}、B_{VCEO}、B_{VCES}、B_{VCBO})

MOSFET (I_{DSS}、I_{GSS}和B_{VDSS})

二极管 (I_R、B_{VR}、V_F)

齐纳二极管 (V_Z、I_Z)

晶闸管 (I_{DM}、B_{VDRM})

J-FET (I_{DSS}、I_{GSS})

光隔离器 (I_{CEO})

稳压器 (+/- V_O, +/- I load)
电流泄露*

* — 测量任意两端之间的电压和电流，电压量高达1,099V，电流范围低至“nA”。该设备用于测试瞬态电压抑制器的钳位电压 (V_{BR})，测量设备的输入阻抗 (根据欧姆法则 R=V/I)，或检测两点之间的泄漏电流 (I leak)。



Website: www.samplesci.com

E-mail: marketing@samplesci.com

总部：上海市桂平路418号A区906室

南京 成都 香港 西安 深圳